

授賞式

日にち：3/12(木)		会場
11：00～12：00	APEX/JJAP貢献賞授賞式、第47回講演奨励賞授賞式	A 304会場
17：00～18：15	第20回応用物理学会業績賞 授賞式、応用物理学会研究分野業績賞 授賞式	A 304会場
18：30～18：40	Exhibition Award贈呈式	学生食堂（懇親会場）

受賞記念講演

■第20回応用物理学会業績賞受賞記念講演

3/12 (木)	青野 正和（物質・材料研究機構）	
13:30 ～ 14:15	タイトル：固体表面の構造と組成の原子レベルでの解析と制御および原子スイッチの発明と開発とその実用 概要：青野正和氏は、1981年、固体表面の原子配列（近接原子間の相対座標）をそれらの原子の元素を同定しつつ定量的に解析するための有用な方法として、イオン散乱分光法の新手法を開発した。この方法では試料に対してHe⁺イオンビーム（～1 keV）を入射し180度の散乱角で完全に逆方向へ後方散乱してくるイオンのみを検出するので、直衝突イオン散乱分光法（ICISS: Impact Collision Ion Scattering Spectroscopy）と名付けられた。このICISSは同軸型ICISS（CAICISS）として改良され、かつ製品化されて、世界の表面科学の進展に大きく貢献した。青野氏はまた、走査型トンネル顕微鏡（STM）は表面の個々の原子を観るだけでなく、個々の原子を操る目的にも使えると考え、その実現のためにERATO事業「青野原子制御表面プロジェクト」を組織した（1989～1994）。この中で、STMの探針によって個々の原子を室温で操ってナノスケールの構造構築を行うための基礎技術を確立した。また、2本の探針を独立に駆動して、試料表面の任意の2点間の電気伝導度を測定する「ナノスター」を世界で初めて実現した。さらに、青野氏は共同研究者とともに、2001年、従来の半導体トランジスタ・スイッチとはまったく異なる原理で動作する「原子スイッチ」を発明した。数個～数十個の金属原子（イオン）の架橋・消滅をナノ電気化学的に制御してON・OFFスイッチングを行わせるもので、半導体を使用しないスイッチである。その後、青野氏はNEC（株）と共同で原子スイッチの実用化のための研究を進め、NEC（株）はFPGA（Field Programmable Gate Array）のスイッチング回路の半導体トランジスタ・スイッチを原子スイッチで置き換えることに成功した。この新しいFPGAは、従来のFPGAに比べてサイズは～1/3、消費電力は～1/10であるだけでなく、電磁ノイズに対する耐性が～100倍、放射線（宇宙線を含む）に対する耐性が～100倍であることがわかった。現在、このFPGAはJAXA によって打ち上げられた人工衛星「革新的衛星技術実証 1 号機」（RAPIS-1）に搭載されて衛星軌道上にあり、宇宙線に対する優れた耐性を示すデータを送ってきている。青野氏の以上の卓越した研究業績は応用物理学会業績賞（研究業績）にきわめて相応しい。当日は、「固体表面の構造と組成の原子レベルでの解析と制御および原子スイッチの発明と開発とその実用」の題目で講演いただく。	
3/14 (土)	本宮 佳典（株式会社東芝）	
13:15 ～ 14:00	タイトル：初学者視点の波動光学 概要：本宮佳典氏は、長年にわたる著作活動と学会活動を通じて、光学の分野を中心に学生及び若手研究者の育成・啓発に貢献してきた。同氏の著作「波動光学の風景」は、業界技術誌で14年以上にわたり続く連載記事であり、その一部はすでに電子書籍化されている。本著作は、波動光学を主な対象とするものであるが、電磁気学に関する内容も多く含まれている。例えば、系の対称性に起因する基本的考察から光学的現象を説明するなど、物理の視点から光学を捉えた書籍ともいえる。また、本著作の最大の特徴は、数式の展開や導出が非常に詳細である点にある。丁寧な数式的記述と物理の解説により、初学者は自身で学習を進めることができる。また、現場の研究者、技術者にとっても、波動光学とその周辺をより深く理解するための格好のテキストとなっている。そのため、学术界、産業界から、良書として高い評価を受けている。さらに同氏は、応用物理学会が主催あるいは協賛するシンポジウムや講習会などで、企業の研究開発現場で長年培ってきた実践的な知見と経験に基づく講義を行い、光学研究者の教育に貢献してきた。また、高野榮一光科学基金の立ち上げに尽力するなど、光学分野の若手研究者の顕彰や育成に貢献している。本宮氏のこれらの卓越した業績は、応用物理学会業績賞（教育業績）として真に相応しいものである。当日は、「初学者視点の波動光学」の題目で講演いただく。	
3/15 (日)	須崎 渉（大阪電気通信大学）	
13:15 ～ 14:00	タイトル：AlGaAs/GaAs系赤色半導体レーザーの先駆的研究と縦型接合ストライプ（TJS）構造の開発による実用化への貢献 概要：須崎渉氏は、半導体レーザーの研究開発黎明期である1967年、液相エピタキシャル成長法（LPE法）によりGaAs基板上に作製したAlGaAs三元混晶を用い、世界に先駆けて赤外光から赤色の波長域（900～780 nm）での室温レーザーパルス発振に成功した。この成果は、同年11月に開催された第1回半導体レーザー国際会議にて発表され、AlGaAs系レーザー開発の端緒となった。この須崎氏の発表によりGaAs基板にほぼ格子整合し結晶欠陥の少ないAlGaAs混晶薄膜の半導体レーザー適用への有用性が示され、アルフレッド氏（1969年）や林氏（1970年）らによる、室温連続発振AlGaAs/GaAsダブルヘテロ（DH）構造レーザーの開発への道を切り開いた。その後須崎氏は、AlGaAs/GaAsダブルヘテロ接合に縦型接合ストライプ（TJS: Transverse Junction Stripe）構造を取り入れ、1973年、世界で初めて低い閾値電流でかつ単一モードで動作する半導体レーザーを実現した。それまでの半導体レーザーでは、横モードが不安定なために光出力－電流（L-I）特性にキック（非直線性）が生じ、光ファイバ通信や光情報処理への適用に大きな障害になっていた。この問題に対して、同氏らが開発したTJSレーザーでは、活性層に対して垂直な方向のみならず平行な方向に対しても狭いストライプを形成することにより、横モードの単一制御を実現でき、キックという応用上の問題を解決することに成功している。須崎氏が開発した技術に基づいて、三菱電機から1978年にTJSレーザーが世界初の量産型実用的半導体レーザーとして市販された（日立製作所と同時期）。また、1980年開催の国際固体素子・材料会議（SSDM）において、AlGaAs系DHLレーザーでは発振波長が750 nm以上において特に長寿命化できることを示し、780 nm帯波長をコンパクトディスク（CD）の実質的な国際標準へ導くことに大きく貢献した。その後同氏は、単一横モード制御された光通信用半導体レーザーの生産数が100万個／月を超え、2009年には同様に単一横モード制御されたDVD用可視レーザーの生産数1600万個／月を達成、同分野でのトップメーカーの1社に成長し、半導体レーザー産業のみならず、広く関連産業の発展にも寄与してきている。須崎氏のこれらの業績は卓越しており、応用物理学会業績賞（研究業績）として真に相応しいものである。当日は、「AlGaAs/GaAs系赤色半導体レーザーの先駆的研究と縦型接合ストライプ（TJS）構造の開発による実用化への貢献」の題目で講演いただく。	

受賞記念講演

<本部関係>

■第10回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤崎勇賞）受賞記念講演

3/13(金) D419会場 13:45 - 14:15	藤田 静雄（京都大学）
	GaAs系、ZnSe系、および酸化物半導体の結晶成長における新技術開拓

■第21回光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）受賞記念講演

3/14(土) B409会場 13:15 - 13:45	洪 鋒雷（横浜国立大学）
	精密周波数計測技術の開発と国際標準への展開

■第10回女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞）受賞記念講演

3/12(木) A408会場 13:15 - 13:45	當麻 真奈（東京工業大学）
	ボトムアッププロセスによる機能性ナノ構造表面の構築
3/14(土) A402会場 11:15 - 11:45	竹岡 裕子（上智大学）
	有機無機ペロブスカイト材料の構造制御と光学応用へ向けた研究
3/15(日) A201会場 09:00 - 09:30	小西 くみこ（日立製作所）
	SiCパワーデバイスの高信頼化に向けたSiC結晶欠陥に関する研究

■第3回光工学業績賞（高野榮一賞）受賞記念講演

3/15(日) B414会場 09:00 - 09:30	鶴田 匡夫（元ニコン）
	古典光学とその応用に関する私的覚書
3/15(日) B414会場 10:30 - 11:00	丸山 晃一（チームオプト株式会社）
	回折素子一体型レンズの設計法の確立と回折光学技術普及への貢献

<分科会関係>

■第4回フォトンクス奨励賞受賞記念講演

3/13(金) B508会場 09:05 - 09:20	縄田 耕二（理化学研究所）
	波長可変バックワードテラヘルツ波パラメトリック発振の実現
3/14(土) B415会場 13:35 - 14:05	吉田 昌宏（京都大学）
	高出力・高ビーム品質二重格子フォトンック結晶レーザー – 大面積（ $\geq 1\text{mm}\Phi$ ）単一モード動作実現に向けて –

■第4回薄膜・表面物理分科会論文賞受賞記念講演

3/12(木) D221会場 10:00 - 10:30	石部 貴史（大阪大学）
	ナノワイヤ界面制御による熱電出力因子増大方法論
3/14(土) A404会場 13:45 - 14:15	中島 秀朗（産業技術総合研究所）
	ロックイン赤外線発熱解析法による大面積グラフェンの構造イメージング

■第11回シリコンテクノロジー分科会論文賞・研究奨励賞受賞記念講演

3/13(金) A305会場	
14:00 - 14:30	岡本 大典（光電子融合基盤技術研究所）
	25-Gb/s × Four-Channel Chip-Scale Optical Receiver Operating at up to 85 °C with a Temperature-Compensation Function
14:30 - 15:00	小野 行徳（静岡大学）
	ナノスケール・シリコンにおける電子・電子散乱を利用したエレクトロン・アスピレーター
15:00 - 15:15	堀 匡寛（静岡大学）
	シリコンMOSTトランジスタにおける電子スピン共鳴下のチャージポンピング
15:15 - 15:30	加藤 公彦（東京大学）
	酸化物半導体／IV族半導体 積層型トンネル電界効果トランジスタ

第47回（2019年秋季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

講演奨励賞とは？

講演奨励賞とは、講演奨励賞とは優秀な一般講演論文を発表した若手会員に与えられる賞です。受賞者は次に行われる講演会で記念講演を行うことができます。一般投稿件数の1%を目安に与えられる名誉ある賞です。

開催日	時間	会場	中分類分科名、講演タイトル、著者（所属）
3/12 (木)	15:30～15:45	B415	3.6 超高速・高強度レーザー
			単層カーボンナノチューブフィルムを用いたCr ²⁺ :ZnS 中赤外モード同期レーザー III
			○岡崎 大樹 ¹ 、荒井 隼人 ² 、Esko Kauppinen ³ 、千足 昇平 ² 、丸山 茂夫 ^{2,4} 、芦原 聡 ¹ (1.東大生研、2.東大工、3.アールト大学、4.産総研)
	13:15～13:30	A302	8.1 プラズマ生成・診断
			フェムト秒レーザー誘起液中プラズマ生成に伴う水和電子の生成、消滅挙動
			○榎原 教貴 ^{1,2,3} 、伊藤 剛仁 ¹ 、寺嶋 和夫 ^{1,2} 、伯田 幸也 ² 、三浦 永祐 ² (1.東大院新領域、2.産総研、3.学振特別研究員)
	09:00～09:15	A405	12.2 評価・基礎物性
			回転型Kelvin Probe装置による表面電位リアルタイム測定法の開発
			○大原 正裕 ¹ 、渡辺 達也 ² 、田中 有弥 ^{1,2,3} 、石井 久夫 ^{1,2,3,4} (1.千葉大工、2.千葉大院融合、3.千葉大先進、4.千葉大 MCRC)
	13:15～13:30	A409	12.4 有機EL・トランジスタ
			STM発光分光法を用いた選択的な三重項励起子形成の単一分子計測
○木村 謙介 ^{1,2} 、三輪 邦之 ^{1,3,5} 、今田 裕 ¹ 、今井 みやび ^{1,2} 、河原 祥太 ^{1,2} 、竹谷 純一 ² 、川合 眞紀 ^{2,4} 、ガルベリン マイケル ³ 、金 有洙 ¹ (1.理研SISL、2.東大院新領域、3.カリフォルニア大学サンディエゴ校、4.分子研、5.ノースウェスタン大学)			
13:15～13:30	A402	12.5 有機太陽電池	
		熱活性化遅延蛍光分子における光電荷分離過程と単一成分薄膜太陽電池への応用	
		○有泉 恒亮 ¹ 、村上 敬祐 ¹ 、末延 知義 ¹ 、鈴木 充朗 ¹ 、中山 健一 ¹ (1.阪大院工)	
13:45～14:00	A303	13.8 光物性・発光デバイス	
		YSiO ₂ Nが有する低/高対称性Y ³⁺ サイトにおけるEu ³⁺ 赤色発光機構の考察	
		○北川 裕貴 ¹ 、上田 純平 ¹ 、田部 勢津久 ¹ (1.京大院人環)	
14:00～14:15	D215	15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	
		X線その場観察法を用いたGaAsSb/GaAs(001)の格子緩和初期における異方性評価	
		○久保 幸士朗 ¹ 、野川 翔太 ¹ 、河野 将大 ¹ 、佐々木 拓生 ² 、高橋 正光 ² 、鈴木 秀俊 ¹ (1.宮崎大工、2.量研)	
16:15～16:30	A401	17.3 層状物質	
		層状マイカ基板上の2次元ピエゾ材料を用いたナノ発電素子	
		○東垂水 直樹 ¹ 、川元 颯巳 ¹ 、梅田 雅也 ¹ 、北浦 良 ² 、長汐 晃輔 ¹ (1.東大工、2.名大理)	
09:45～10:00	D419	21.1 合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	
		自己組織化単分子膜と酸化物薄膜トランジスタを用いた高信頼・安定性を有する化学センサ開発	
		○橋岡 裕貴 ¹ 、高橋 崇典 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、浦岡 行治 ¹ (1.奈良先端大)	
3/13 (金)	13:15～13:30	B415	3.3 情報フォトリソ・画像工学
			グレーティングの重複を除いた表面型ホログラフィックメモリーにおける記録再生特性の評価
			○平山 颯紀 ¹ 、藤村 隆史 ² 、田中 嘉人 ¹ 、志村 努 ¹ (1.東大生研、2.宇都宮大工)
	09:00～09:15	B409	3.12 ナノ領域光学・近接場光学
			プラズモニクナノ構造体における第二高調波の放射制御
			○木村 友哉 ¹ 、田中 嘉人 ¹ 、志村 努 ¹ (1.東大生研)
	13:45～14:00	D411	6.3 酸化物エレクトロニクス
			酸水素化ランタン LaH _{3-2x} O _x の高速ヒドリドイオン伝導とその機構
			○福井 慧賢 ¹ 、飯村 壮史 ¹ 、多田 朋史 ¹ 、藤津 悟 ¹ 、笹瀬 雅人 ¹ 、玉造 博夢 ² 、本田 孝志 ² 、池田 一貴 ² 、大友 季哉 ² 、細野 秀雄 ¹ (1.東工大、2.高工ネ研)
	13:45～14:00	D519	6.6 フローブ顕微鏡
			原子間力顕微鏡を用いたルチル型酸化チタン表面上の酸素原子の電荷状態と結合状態の制御
○安達 有輝 ¹ 、温 煥飛 ¹ 、張 全震 ¹ 、宮崎 雅大 ¹ 、菅原 康弘 ¹ 、Hongqian Sang ² 、Ján Brndiar ³ 、Lev Kantorovich ² 、Ivan Štich ³ 、YanJun Li ¹ (1.阪大院工、2.King's College London、3.Slovak Academy of Sciences)			
11:30～11:45	D519	9.1 誘電材料・誘電体	
		レクテナ昇圧素子に向けたSMR型傾斜反転ScAlN圧電薄膜トランス	
		○木下 紗里那 ^{1,2} 、柳谷 隆彦 ^{1,2,3} (1.早大先進理工、2.材研、3.JSTさきがけ)	
10:45～11:00	D305	9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	
		ZnOナノワイヤによる官能基位置選択的な直鎖ケトンの自動酸化促進	
		○細見 拓郎 ^{1,2} (1.九大先導研、2.JSTさきがけ)	
11:00～11:15	B406	11.1 基礎物性	
		REBCO溶融凝固/バブルにおける高速酸素アニールプロセスの開発と酸素拡散機構の考察	
		○元木 貴則 ¹ 、布川 航太 ¹ 、筋内 優 ¹ 、権藤 紳吉 ¹ 、中村 新一 ² 、下山 淳一 ¹ (1.青山学院大理工、2.TEP)	
13:15～13:30	A404	12.1 作製・構造制御	
		超分子のアプローチによる量子ドット集合体の光制御	
		○山内 光陽 ¹ 、増尾 貞弘 ¹ (1.関西学院大理工)	
13:15～13:30	A408	12.7 医用工学・バイオチップ	
		細胞培養ゲートFETによる <i>in situ</i> 細胞活動計測と細胞 / ゲート電極界面におけるイオン挙動の理解	
		○佐竹 皓宇 ¹ 、齋藤 暁宇 ² 、坂田 利弥 ² (1.キャンノンメディカルシステムズ、2.東大院工)	
15:45～16:00	A305	13.5 デバイス／配線／集積化技術	
		InAs-On-Insulator基板の高品質化と貼り合わせ界面特性の評価	
		○隅田 圭 ¹ 、加藤 公彦 ¹ 、竹安 淳 ¹ 、トブラサートボン カシディット ¹ 、竹中 充 ¹ 、高木 信一 ¹ (1.東大院工)	
13:30～13:45	A202	13.9 化合物太陽電池	
		化合物太陽電池を応用した電源レス・高耐放射線性の線量計開発	
		○奥野 泰希 ¹ 、今泉 充 ² 、後藤 康仁 ³ 、秋吉 優史 ⁴ 、小林 知洋 ⁵ 、岡本 保 ⁶ (1.原子力機構、2.宇宙機構、3.京大、4.阪府大、5.理研、6.木更津高専)	

第47回（2019年秋季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

開催日	時間	会場	中分類分科名、講演タイトル、著者（所属）
3/13 (金)	13:30～13:45	A302	15.4 III-V族窒化物結晶
			らせん転位とMg不純物との複合体を含むGaNの第一原理電子構造解析 ○中野 崇志 ¹ 、原嶋 庸介 ² 、長川 健太 ² 、洗平 昌晃 ^{2,1} 、白石 賢二 ^{2,1} 、押山 淳 ² 、草場 彰 ³ 、寒川 義裕 ^{4,2} 、田中 敦之 ² 、本田 善央 ^{2,1} 、天野 浩 ^{2,1} (1.名大院工、2.名大未来研、3.学習院大計算機センター、4.九大応力研)
3/14 (土)	15:30～15:45	B408	3.1 光学基礎・光学新領域
			光洞超短パルスレーザーによるアソポリマーのキラルレリーフ形成 ○増田 圭吾 ¹ 、篠崎 諒 ¹ 、一條 瑞樹 ¹ 、白石 朋 ¹ 、山根 啓作 ² 、宮本 克彦 ^{1,3} 、尾松 孝茂 ^{1,3} (1.千葉大院融合理工、2.北海道大工学研究院、3.千葉大分子キラリティ研究センター)
	09:00～09:15	B409	3.8 光計測技術・機器
			シングルショット超高速波形計測のための高速光周波数コムアナライザ ○多田 浩明 ¹ 、湯田 怜央奈 ¹ 、今井 颯 ¹ 、三木 真人 ¹ 、塩田 達俊 ¹ (1.埼玉大理工)
	13:35～14:05	B415	3.11 フォトニック構造・現象
			高出力・高ビーム品質二重格子フォトニック結晶レーザー ー大面積 (≥1mmΦ) 単一モード動作実現に向けてー ○吉田 昌宏 ¹ 、De Zoysa Menaka ¹ 、石崎 賢司 ¹ 、井上 卓也 ¹ 、野田 進 ¹ (1.京大院工)
	09:00～09:15	D221	6.2 カーボン系薄膜
			熱フィラメントCVD成長によるダイヤモンドのn型ドーピング ○片宗 優貴 ¹ 、森 大地 ¹ 、有川 大輔 ¹ 、和泉 亮 ¹ 、嶋岡 毅紘 ² 、市川 公善 ² 、小泉 聡 ² (1.九州工大、2.物材機構)
	13:45～14:00	D221	6.2 カーボン系薄膜
			ドレスト状態生成によるダイヤモンドNV中心のコヒーレンス時間の長時間化 ○山下 峻吾 ¹ 、森下 弘樹 ¹ 、Ernst David Herbschleb ¹ 、徳田 規夫 ² 、水落 憲和 ¹ (1.京大化研、2.金沢大)
	09:00～09:15	A501	10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術
			Control of perpendicular magnetic anisotropy of Co thin films formed on a flexible substrate by using a biaxial stretching technique ○Hiroyuki Matsumoto ^{1,2} , Shinya Ota ^{1,2} , Tomohiro Koyama ^{2,3} , Daichi Chiba ^{2,3} (1.The Univ. of Tokyo, 2.ISIR, Osaka Univ., 3.CSRN-Osaka)
	09:15～09:30	A501	10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術
			マイクロ波重畳パルスによる電圧トルク磁化反転精度の改善 ○山本 竜也 ¹ 、野崎 隆行 ¹ 、今村 裕志 ¹ 、田丸 慎吾 ¹ 、薬師寺 啓 ¹ 、久保田 均 ¹ 、福島 章雄 ¹ 、鈴木 義茂 ^{1,2} 、湯浅 新治 ¹ (1.産総研、2.大阪大学)
	10:00～10:15	A402	12.5 有機太陽電池
			Lead-free tin-germanium (SnGe) halide perovskite solar cells with more than 10 % efficiencies ○Muhammad Akmal Kamarudin ¹ , Daisuke Hirotsu ² , Kengo Hamada ² , Kohei Nishimura ¹ , Shen Qing ¹ , Satoshi Iikubo ² , Takashi Minemoto ³ , Kenji Yoshino ⁴ , Shuzi Hayase ¹ (1.Univ. of Electro-Com, 2.Kyushu Inst. Of Tech, 3.Ritsumeikan Univ, 4.Univ. of Miyazaki)
	13:45～14:00	A305	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術
			Arイオン照射窒化ガリウム表面の塩素吸着層のイオンエネルギー依存性 (2) ○長谷川 将希 ¹ 、堤 隆嘉 ¹ 、谷出 敦 ^{1,2} 、近藤 博基 ¹ 、関根 誠 ¹ 、石川 健治 ¹ 、堀 勝 ¹ (1.名大、2.SCREENホールディングス)
	13:45～14:00	A302	15.4 III-V族窒化物結晶
			Naフラックスポイントシード法を用いたGaN結晶成長と新しい試み ○今西 幸一 ¹ 、村上 航介 ¹ 、奥村 加奈子 ¹ 、中村 幸介 ¹ 、垣之内 啓介 ¹ 、北村 智子 ¹ 、吉村 政志 ^{1,2} 、森 勇介 ¹ (1.阪大院工、2.阪大レーザー研)
	11:15～11:30	A407	16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
			変位型相変化に伴うMnTe薄膜の電気的および光学的スイッチング ○森 竣祐 ¹ 、安藤 大輔 ¹ 、須藤 祐司 ¹ (1.東北大工)
	16:30～16:45	A404	17.3 層状物質
			ゼーマン型スピン軌道相互作用を有するファンデアワールス・ヘテロ界面における磁気特性 ○松岡 秀樹 ¹ 、Stewart Barnes ² 、家田 淳 ³ 、前川 禎通 ^{4,5} 、Mohammad Bahrany ^{1,4} 、王 越 ¹ 、吉田 訓 ¹ 、石坂 香子 ^{1,4} 、岩佐 義宏 ^{1,4} 、中野 匡規 ^{1,4} (1.東大院工、2.マイアミ大、3.原子力機構、4.理研CEMS、5.中国科学院大学KITS)
	10:45～11:00	A405	22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」
			アモルファス酸化物薄膜の熱物性；(1)アモルファスAl ₂ O ₃ 薄膜における熱伝導率制御 ○安倍 知奈実 ¹ 、山下 雄一郎 ^{1,2} 、田中 幸美 ² 、八木 貴志 ^{1,2} 、柏木 誠 ¹ 、貫 重軍 ³ 、服部 浩一郎 ² 、竹歳 尚之 ^{1,2} 、岡島 敏浩 ⁴ 、小口 有希 ⁵ 、重里 有三 ¹ (1.青学大、2.産総研、3.早大国際理工学C、4.あいちSR、5.青学大機器分析C)
3/15 (日)	13:15～13:30	D305	1.6 超音波
			LiNbO ₃ /SiO ₂ /水晶構造におけるリーキーSAWの解析 ○浅川 詩織 ¹ 、林 純貴 ¹ 、鈴木 雅視 ¹ 、垣尾 省司 ¹ 、手塚 彩水 ² 、桑江 博之 ² 、水野 潤 ² (1.山梨大工、2.早稲田大)
	11:30～11:45	D511	2.3 放射線応用・発生装置・新技術
			原子層堆積法の宇宙X線望遠鏡への応用 ○福島 碧都 ¹ 、伊師 大貴 ¹ 、江副 祐一郎 ¹ 、石川 久美 ² 、沼澤 正樹 ¹ 、大坪 亮太 ¹ 、鈴木 光 ¹ 、湯浅 辰哉 ¹ 、内野 友樹 ¹ 、作田 紗恵 ¹ 、満田 和久 ² (1.首都大、2.宇宙研)
	09:00～09:15	B410	3.1 光学基礎・光学新領域
			GeSbTe基板上におけるマイクロ液滴の光操作 ○高松 有花 ¹ 、山本 詠士 ¹ 、江刺家 恵子 ¹ 、桑原 正史 ² 、斎木 敏治 ¹ (1.慶大院理工、2.産総研)
	13:15～13:30	B309	3.4 生体・医用光学
			振動分光フローサイトメトリーの開発と大規模一細胞解析への応用 ○平松 光太郎 ^{1,2} 、合田 圭介 ^{1,3,4} (1.東大院理、2.JSTさきがけ、3.武漢大学、4.UCLA)
	10:45～11:00	D215	7.2 電子ビーム応用
			Graphene/h-BN平面型電子源からの単色電子放出 ○猪狩 朋也 ^{2,1} 、長尾 昌善 ¹ 、三石 和貴 ³ 、佐々木 正洋 ² 、山田 洋一 ² 、村上 勝久 ^{1,2} (1.産総研、2.筑波大、3.物材機構)